

10/518119

REC'D	01 SEP 2003
WIPO	PCT



PCT/FR03/01868

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 20 JUIN 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété Industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

BEST AVAILABLE COPY

BREVET D'INVENTION

26bis, rue de Saint-Pétersbourg

75800 Paris Cédex 08

Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livreVI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: 18 juin 2002 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: 0207501 DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: 75 DATE DE DÉPÔT: 18 JUIN 2002	Claude JUPIN HARLE ET PHELIP 7, rue de Madrid 75008 PARIS France
Vos références pour ce dossier: N930FR	

1 NATURE DE LA DEMANDE Demande de brevet					
2 TITRE DE L'INVENTION Chambre d'évaporation de matériaux sous vide à pompage différentiel					
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE		Pays ou organisation	Date		
4-1 DEMANDEUR <table border="1"> <tr> <td> Nom Rue Code postal et ville Pays Nationalité Forme Juridique </td> <td> RIBER 133 Bd National 92500 RUEIL MALMAISON France France Société anonyme à directoire et conseil de surveillance </td> </tr> </table>				Nom Rue Code postal et ville Pays Nationalité Forme Juridique	RIBER 133 Bd National 92500 RUEIL MALMAISON France France Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Nom Rue Code postal et ville Pays Nationalité Forme Juridique	RIBER 133 Bd National 92500 RUEIL MALMAISON France France Société anonyme à directoire et conseil de surveillance				
5A MANDATAIRE <table border="1"> <tr> <td> Nom Prénom Qualité Cabinet ou Société Rue Code postal et ville N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique </td> <td> JUPIN Claude CPI: b [2000-0193 HARLE ET PHELIP 7, rue de Madrid 75008 PARIS 0153046464 0153046400 cabinet@harle.fr </td> </tr> </table>				Nom Prénom Qualité Cabinet ou Société Rue Code postal et ville N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique	JUPIN Claude CPI: b [2000-0193 HARLE ET PHELIP 7, rue de Madrid 75008 PARIS 0153046464 0153046400 cabinet@harle.fr
Nom Prénom Qualité Cabinet ou Société Rue Code postal et ville N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique	JUPIN Claude CPI: b [2000-0193 HARLE ET PHELIP 7, rue de Madrid 75008 PARIS 0153046464 0153046400 cabinet@harle.fr				
6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS		Fichier électronique	Pages		
Description Revendications Dessins Abrégé Figure d'abrégé Listage de séquences Rapport de recherche		desc.pdf V	10 3 3 V 1		
			13 3 fig., 1 ex. fig. 2; 1 ex.		
8 RAPPORT DE RECHERCHE					
Etablissement immédiat					

8 RAPPORT DE RECHERCHE

Etablissement immédiat

9 REDEVANCES JOINTES

062 Dépôt

063 Rapport de recherche (R.R.)

068 Revendication à partir de la 11ème

Total à acquitter

Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
EURO	35.00	1.00	35.00
EURO	320.00	1.00	320.00
EURO	15.00	3.00	45.00
EURO			400.00

10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE

Signé par

Claude JUPIN



La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention concerne une chambre d'évaporation de matériaux sous vide.

L'état de propreté d'une surface ou de pureté d'un film déposé sont primordiales dans des domaines techniques tels que les nanotechnologies, la chimie catalytique, les biotechnologies,... Dans les nanotechnologies, par exemple, dont le champ d'application porte sur des objets de l'ordre de quelques nanomètres à quelques micromètres, la compréhension de phénomènes tels que la croissance de films, les réactions photoinduites dans lesdits films ne peut se faire que si les films et, 10 les substrats sur lesquels ils sont formés, sont vierges de toute contamination.

Dans le domaine des semi-conducteurs, la croissance de films présentant peu d'impuretés, et donc peu de dopants non intentionnels, est également essentielle. Le dépôt de matériaux purs en quantité connue sur des surfaces semi-conductrices est, en effet, particulièrement important pour la réalisation de jonctions métal-semi-conducteurs et hétérostructures semi-conductrices. Les 20 premières se retrouvent dans tous les contacts métalliques des dispositifs semi-conducteurs, par exemple, les contacts ohmiques de détecteur électronique. Les secondes sont importantes pour les dispositifs optoélectroniques.

Enfin, les hétérostructures métalliques connaissent 25 également un intérêt marqué de part leurs applications possibles dans des domaines tels que le magnétisme.

Une des techniques courantes pour préparer de telles structures sous ultravide est l'Epitaxie par Jet Moléculaire ("MBE"- Molecular Beam Epitaxy). Avec cette technique, des couches épitaxiales sont obtenues par le transport du matériau, contenant les éléments constitutifs de la couche à former, jusqu'à un substrat, métallique ou semi-conducteur, où il s'adsorbe. L'Epitaxie par Jet Moléculaire permet d'obtenir, en particulier pour les semi-conducteurs, une croissance de couches contrôlées en dopage et

dont la composition chimique peut être variée en profondeur sur l'espace de quelques angströms.

Une chambre d'évaporation comprend donc plusieurs sources de matériau 1 (Figure 1). Ces sources 1 sont utilisées alternativement 5 en fonction de l'empilement de couches à former. Diverses sources de matériau 1 peuvent être envisagées, la plus courante étant l'évaporation à partir d'une cellule comportant un creuset chauffé par effet Joule. D'autres possibilités comprennent l'utilisation d'une source de plasma dont le gaz est, par exemple, de l'oxygène (O₂), 10 de l'hydrogène (H₂), de l'azote (N₂) ou autres, ou des injecteurs à gaz ou encore des canons à évaporation par bombardement électronique. Lorsque ces sources 1 sont des cellules, leurs creusets ont généralement une forme cylindrique ou conique ou autre, ouverte à une extrémité 2 et sont montés de telle sorte que 15 ladite ouverture 2 est placée en regard du substrat 3 sur lequel le dépôt de matériau doit être opéré.

Comme décrit précédemment, un des impératifs de ces systèmes de déposition est la faible contamination des films formés. Outre le dépôt de matériau dans une chambre 4 sous vide et de préférence 20 sous ultra-vide, i.e. à une pression inférieure à 10⁻⁹ Torr, les sources de matériau 1 ne doivent pas, elles-mêmes, être une source éventuelle de contamination. Elles sont donc l'objet d'un dégazage poussé.

Cependant, la présence de plusieurs sources 1 dans la chambre 25 d'évaporation est à l'origine d'un autre type de contamination : une contamination croisée des sources de matériau 1. Cette contamination peut, en partie, être celle des sources solides par les gaz en présence (ionisé ou non). Lorsque l'une de ces sources 30 1 est utilisée par la suite, non seulement les éléments dudit creuset sont évaporés en direction du substrat 3 mais éventuellement aussi des éléments contaminateurs adsorbés ou ayant réagis avec ladite source. La couche ainsi déposée sur le substrat 3 contient alors 35 des impuretés non intentionnelles qui peuvent influer en cas de matériau semi-conducteur non seulement sur son dopage mais également sur les propriétés du matériau. La présence de

dont la composition chimique peut être variée en profondeur sur l'espace de quelques angströms.

Une chambre d'évaporation comprend donc plusieurs sources de matériau 1 (Figure 1). Ces sources 1 sont utilisées alternativement 5 en fonction de l'empilement de couches à former. Diverses sources de matériau 1 peuvent être envisagées, la plus courante étant l'évaporation à partir d'une cellule comportant un creuset chauffé par effet Joule. D'autres possibilités comprennent l'utilisation d'une source de plasma dont le gaz est, par exemple, de l'oxygène (O_2), 10 de l'hydrogène (H_2), de l'azote (N_2) ou autres, ou des injecteurs à gaz ou encore des canons à évaporation par bombardement électronique. Lorsque ces sources 1 sont des cellules, leurs creusets ont généralement une forme cylindrique ou conique ou autre, ouverte à une extrémité 2 et sont montés de telle sorte que 15 ladite ouverture 2 est placée en regard du substrat 3 sur lequel le dépôt de matériau doit être opéré.

Comme décrit précédemment, un des impératifs de ces systèmes de déposition est la faible contamination des films formés. Outre le dépôt de matériau dans une chambre 4 sous vide et de préférence 20 sous ultra-vide, i.e. à une pression inférieure à 10^{-9} mbar, les sources de matériau 1 ne doivent pas, elles-mêmes, être une source éventuelle de contamination. Elles sont donc l'objet d'un dégazage poussé.

Cependant, la présence de plusieurs sources 1 dans la chambre 25 d'évaporation est à l'origine d'un autre type de contamination : une contamination croisée des sources de matériau 1. Cette contamination peut, en partie, être celle des sources solides par les gaz en présence (ionisé ou non). Lorsque l'une de ces sources 1 est utilisée par la suite, non seulement les éléments dudit creuset 30 sont évaporés en direction du substrat 3 mais éventuellement aussi des éléments contaminateurs adsorbés ou ayant réagis avec ladite source. La couche ainsi déposée sur le substrat 3 contient alors des impuretés non intentionnelles qui peuvent influer en cas de matériau semi-conducteur non seulement sur son dopage mais 35 également sur les propriétés du matériau. La présence de

panneaux réservoirs 5 à circulation d'azote liquide placés au voisinage de ces sources 1 pour condenser les gaz et de caches individuels 6 placés devant les sources 1 non utilisées ne constitue pas une solution totalement satisfaisante pour éviter cette 5 contamination croisée.

10 L'objectif de la présente invention est de proposer une chambre d'évaporation de matériaux sous vide, simple dans sa conception et dans son mode opératoire, comprenant des sources d'évaporation de matériau pour la croissance de couches sur un substrat qui soient protéger de tout type de contamination.

A cet effet, l'invention concerne une chambre d'évaporation de matériaux comprenant une chambre à vide, une première unité de pompage pour pomper ladite chambre et des sources de matériau.

15 Selon l'invention,

- une paroi pouvant assurer une étanchéité totale ou partielle au vide, délimite au sein de la chambre à vide un premier volume pompé par ladite première unité de pompage et un deuxième volume pompé par une deuxième unité de pompage,
- certaines desdites sources de matériau ayant un axe principal sont placées dans le deuxième volume et d'autres sources sont placées dans le premier volume,
- ladite paroi comporte des évidements, chaque évidement étant centré sur l'axe principal d'une des sources de matériau ayant un axe principal,

et

- la chambre comprend des moyens pour obturer ou dégager chacun desdits évidements, lesdits moyens étant contrôlés individuellement pour protéger les sources de matériau ayant un axe principal non utilisées.

30 La présente invention concerne également les caractéristiques qui ressortiront au cours de la description qui va suivre et qui devront être considérées isolément ou selon toutes 35 leurs combinaisons techniquement possibles :

- les moyens pour obturer ou dégager lesdits évidements comprennent des caches,

5 - lors d'une croissance, le débit, à travers les évidements dégagés, des éléments constitutifs des matériaux venant du premier volume est pompé par la deuxième unité de pompage.

On entend par "croissance", le développement progressif de couches sur l'échantillon par l'adsorption des éléments constitutifs des matériaux évaporés par les sources placées dans la chambre d'évaporation. On distingue la croissance en coévaporation dans 10 laquelle au moins une des sources de matériau placées dans le premier volume et au moins une des sources placées dans le deuxième volume sont mises en oeuvre simultanément et la croissance séquentielle où une seule des sources placées dans la chambre d'évaporation est en fonctionnement à la fois. Dans ce 15 dernier cas, lors de l'opération d'une des sources placées dans le premier volume, les moyens pour obturer ou dégager chacun desdits évidements sont en position d'obturation.

20 - la paroi pouvant assurer une étanchéité totale ou partielle au vide comprend une plaque,

25 - la première unité de pompage comprend une pompe primaire et une pompe secondaire,

- la deuxième unité de pompage comprend une pompe secondaire,

30 - le premier volume et le deuxième volume comprennent au moins un panneau réservoir à azote liquide,

- le deuxième volume délimité par la paroi est à une pression inférieure à 10^{-7} Torr.

- la chambre d'évaporation comprend des moyens de contrôle de la pression pour mesurer indépendamment la pression dans le premier volume et le deuxième volume,

- les sources de matériau ayant un axe principal placées dans le deuxième volume comprennent des cellules à creusets chauffés par effet Joule,

- les moyens pour obturer ou dégager lesdits évidements comprennent des caches,

5 - lors d'une croissance, le débit, à travers les évidements dégagés, des éléments constitutifs des matériaux venant du premier volume est pompé par la deuxième unité de pompage.

..... On entend par "croissance", le développement progressif de couches sur l'échantillon par l'adsorption des éléments constitutifs des matériaux évaporés par les sources placées dans la chambre d'évaporation. On distingue la croissance en coévaporation dans 10 laquelle au moins une des sources de matériau placées dans le premier volume et au moins une des sources placées dans le deuxième volume sont mises en oeuvre simultanément et la croissance séquentielle où une seule des sources placées dans la chambre d'évaporation est en fonctionnement à la fois. Dans ce 15 dernier cas, lors de l'opération d'une des sources placées dans le premier volume, les moyens pour obturer ou dégager chacun desdits évidements sont en position d'obturation.

- la paroi pouvant assurer une étanchéité totale ou partielle au vide comprend une plaque,

20 - la première unité de pompage comprend une pompe primaire et une pompe secondaire,

- la deuxième unité de pompage comprend une pompe secondaire,

- le premier volume et le deuxième volume comprennent au 25 moins un panneau réservoir à azote liquide,

- le deuxième volume délimité par la paroi est à une pression inférieure à 10^{-7} mbar.

30 - la chambre d'évaporation comprend des moyens de contrôle de la pression pour mesurer indépendamment la pression dans le premier volume et le deuxième volume,

- les sources de matériau ayant un axe principal placées dans le deuxième volume comprennent des cellules à creusets chauffés par effet Joule,

- les sources de matériau ayant un axe principal placées dans le deuxième volume comprennent des canons à évaporation par bombardement électronique,
- les sources placées dans le premier volume comprennent au moins une source de plasma,
- les sources placées dans le premier volume comprennent au moins un injecteur à gaz.

L'invention sera décrite plus en détail en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique d'une chambre d'évaporation de l'art antérieur,
- la figure 2 est une représentation schématique d'une chambre d'évaporation de matériaux, selon un mode de réalisation de l'invention;
- la figure 3 est une vue de dessus d'une paroi pouvant assurer une étanchéité totale ou partielle au vide, selon un mode de réalisation de l'invention;

La chambre d'évaporation de matériaux, selon l'invention, comprend une chambre à vide 10 comportant un échantillon 11 pouvant être monté sur un manipulateur 12. Cette chambre a pour objectif premier la croissance de couches par évaporation de matériaux purs et en quantité connue sur cet échantillon 11. Il s'agit de tout type de matériau pouvant être usuellement évaporé sous vide (Aluminium (Al), Calcium (Ca), Indium (In), Lanthane (La), Lithium (Li), Gallium (Ga), Strontium (Sr), Titane (Ti), Yttrium (Y), Zirconium (Zr), ...). Ladite chambre 10 comporte de préférence des brides ou piquages de transfert permettant de relier celle-ci à d'autres chambres pour constituer un ensemble unique sous vide pour le traitement et la préparation d'un échantillon 11, voire l'analyse et la modification dudit échantillon 11 formé. Le transport dudit échantillon 11 d'une chambre à une autre est alors réalisé par des bras manipulateurs.

La chambre d'évaporation est pompée par une première unité de pompage 13. Cette première unité de pompage 13 comprend

préférentiellement une pompe primaire et une pompe secondaire, par exemple, une pompe cryogénique ou une pompe turbomoléculaire, ou autre. En outre, ladite unité de pompage 13 peut comprendre un sublimateur de Titane 14 et un panneau 5 cryogénique 15. La chambre 10 peut comprendre un panneau cryogénique général 16 permettant de maintenir la pureté des couches. La chambre comprend également des moyens de contrôle de la pression au sein de celle-ci. Ces moyens de contrôle comprennent, par exemple, des jauge dites BAYARD-ALPERT 10 reliées à un dispositif externe de contrôle de la pression.

La chambre d'évaporation comprend des sources de matériau. Diverses sources de matériau peuvent être envisagées, la plus courante étant l'évaporation à partir d'une source 17 du type Knudsen. Il s'agit alors d'un creuset chauffé par effet Joule. 15 Le creuset qui peut être réalisé en nitre de Bore ou en graphite de haute pureté, par exemple, présente une forme cylindrique ou conique ou autre, ayant un axe principal 18. L'une des extrémités 19 dudit creuset est ouverte et placée en vis-à-vis du manipulateur 12. Cet effet Joule peut être obtenu par l'utilisation d'un élément 20 résistant par exemple, un filament. Le filament est avantageusement réalisé en Tantale (Ta) mais peut également être réalisé en d'autres matériaux réfractaires (Molybdène (Mo), Tungstène (W),). Dans un autre mode de réalisation, l'évaporation est générée par le bombardement électronique d'un 25 matériau source dans un canon d'évaporation 20.

La chambre d'évaporation comprend aussi d'autres sources de matériau 21 telles que des sources de plasma ou des injecteurs à gaz dont le produit est susceptible de réagir avec les matériaux des sources 17 ayant un axe principal 18. Cet axe principal 18 définit 30 également un axe principal d'évaporation. Le gaz support du plasma ou le gaz de l'injecteur est alors choisi parmi l'oxygène (O_2), l'azote (N_2), l'hydrogène (H_2), ... De préférence, l'échantillon 11 est également contrôlé en température, i.e. sa température peut être variée selon les éléments à déposer sur la surface dudit 35 échantillon 11.

Selon l'invention, les sources de matériau 17 ayant un axe principal 18 sont placées dans un volume délimité 22 au sein de ladite chambre par une paroi 23. Cette paroi 23 peut assurer une étanchéité totale ou partielle au vide et le volume délimité 22 par la 5 paroi 23 est pompé par une deuxième unité de pompage 24. Cette paroi 23 est dans un mode de réalisation réalisé en métal (Tantale, Molybdène, inox, ...). On distinguera donc un premier volume 25 contenant les sources 21 telles que sources à plasma ou injecteurs 10 à gaz, ledit volume étant pompé par la première unité de pompage 13, et un deuxième volume 22 comprenant les sources de matériaux 17 ayant un axe principal 18 telles que des cellules à creuset, et des canons d'évaporation 20 par bombardement 15 électronique.

Ladite paroi 23 comporte des évidements 26, chaque 15 évidement 26 étant centré sur l'axe principal 18 d'une des sources de matériau 17 ayant un axe principal 18 placées dans le deuxième volume 22. Lorsque la source de matériau 17 correspondante à un évidement 26 est en fonctionnement, le jet moléculaire émis par cette source traverse dans son transport vers l'échantillon 11 ledit 20 évidement 26. Afin de maintenir un vide poussé dans le deuxième volume 22 délimité par la paroi 23, i.e. une pression inférieure à 10^{-7} Torr et préférentiellement à 10^{-9} Torr, la chambre 10 comprend 25 des moyens 27 pour obturer chacun desdits évidements 26. Ces moyens 27 sont contrôlés individuellement pour dégager l'évidement 26 d'une source de matériau 17 sélectionnée. Ces moyens 27 pour obturer chacun desdits évidements 26 sont dans 30 un mode de réalisation des caches, par exemple, à basculement ou linéaires, ou autres. Ces moyens 27 permettent de protéger les sources de matériaux 17 d'éventuelles contaminations. Ces 35 contaminations peuvent résulter, par exemple, de l'opération d'une des sources 21 (injecteur à gaz, source de plasma, ...) placées dans le premier volume 25. Avantageusement, la pression partielle p_1 mesurée dans le premier volume 25 lors d'un dépôt n'affecte sensiblement pas la pression p_2 mesurée dans le deuxième volume 22 pompé par la deuxième unité de pompage. En d'autres termes,

Selon l'invention, les sources de matériau 17 ayant un axe principal 18 sont placées dans un volume délimité 22 au sein de ladite chambre par une paroi 23. Cette paroi 23 peut assurer une étanchéité totale ou partielle au vide et le volume délimité 22 par la paroi 23 est pompé par une deuxième unité de pompage 24. Cette paroi 23 est dans un mode de réalisation réalisé en métal (Tantale, Molybdène, inox, ...). On distinguera donc un premier volume 25 contenant les sources 21 telles que sources à plasma ou injecteurs à gaz, ledit volume étant pompé par la première unité de pompage 13, et un deuxième volume 22 comprenant les sources de matériaux 17 ayant un axe principal 18 telles que des cellules à creuset, et des canons d'évaporation 20 par bombardement électronique.

Ladite paroi 23 comporte des évidements 26, chaque évidement 26 étant centré sur l'axe principal 18 d'une des sources de matériau 17 ayant un axe principal 18 placées dans le deuxième volume 22. Lorsque la source de matériau 17 correspondante à un évidement 26 est en fonctionnement, le jet moléculaire émis par cette source traverse dans son transport vers l'échantillon 11 ledit évidement 26. Afin de maintenir un vide poussé dans le deuxième volume 22 délimité par la paroi 23, i.e. une pression inférieure à 10^{-7} mbar et préférentiellement à 10^{-9} mbar, la chambre 10 comprend des moyens 27 pour obturer chacun desdits évidements 26. Ces moyens 27 sont contrôlés individuellement pour dégager l'évidement 26 d'une source de matériau 17 sélectionnée. Ces moyens 27 pour obturer chacun desdits évidements 26 sont dans un mode de réalisation des caches, par exemple, à basculement ou linéaires, ou autres. Ces moyens 27 permettent de protéger les sources de matériaux 17 d'éventuelles contaminations. Ces contaminations peuvent résulter, par exemple, de l'opération d'une des sources 21 (injecteur à gaz, source de plasma, ...) placées dans le premier volume 25. Avantageusement, la pression partielle p_1 mesurée dans le premier volume 25 lors d'un dépôt n'affecte sensiblement pas la pression p_2 mesurée dans le deuxième volume 22 pompé par la deuxième unité de pompage. En d'autres termes,

lors d'une croissance, le débit des éléments constitutants le plasma, par exemple, à travers les évidements 26 ouverts est inférieur à la vitesse de pompage S de la deuxième unité 24 de pompage et est donc pompé par celle-ci. Cependant, même si ledit débit est 5 supérieur à la vitesse de pompage, le principe de pompage différentiel permet quand même la protection des sources de matériaux 17. En effet, la quantité des éléments constitutants le plasma qui aura pénétré dans la partie basse de la chambre sera pompée par la deuxième unité de pompage 24, une fois les 10 évidements 26 de la paroi 23 obturés par les caches 27 fermés. Le temps de présence des éléments constitutants le plasma à proximité des sources de matériaux 17 ne sera donc que limité. La deuxième unité de pompage 24 comprend au moins une pompe secondaire telle qu'une pompe cryogénique, une pompe turbomoléculaire ou 15 autre. Le deuxième volume 22 délimité par la paroi 23 peut aussi comporter au moins un panneau réservoir 28 à circulation d'Azote liquide. Ces surfaces de condensation supplémentaires permettent de limiter la présence d'impuretés dans le jet moléculaire et dans le deuxième volume 22. De préférence, la pression dans le 20 deuxième volume 22 délimité par la paroi 23 est mesurée par des moyens de contrôle de la pression du type jauge dite BAYARD-ALPERT.

La figure 2 montre un mode de réalisation de l'invention. Le volume de la chambre d'évaporation est divisée en un premier 25 volume 25 et un deuxième volume 22 par une paroi 23. Cette paroi 23 est une plaque en molybdène qui est fixée sur les murs latéraux 29 de l'enceinte 10 de façon à assurer une étanchéité totale ou partielle au vide. Elle est dans ce cas soudée ou fixée aux dits murs 29. Cette plaque 23 comporte des évidements 26 dont un seul 30 est schématisé sur la figure 2 par simplification. Cet évidement 26 est centré sur l'axe principal 18 d'une source de matériau 17 placée dans le deuxième volume 22 délimité par la plaque 23, dans la partie basse de la chambre d'évaporation. Des moyens 35 27 permettent d'obturer et de dégager ledit évidement 26. Ces moyens 27 comprennent un cache à basculement activé par un dispositif

externe de basculement 30. Chaque cache 27 est contrôlé individuellement. Lorsqu'un cache 27 est en position d'obturation, la lame 31 du cache est parallèle à la surface de la plaque 23 autour de l'évidement 26 considéré de manière à assurer un contact parfait entre ladite surface et le cache 27. Cette étanchéité est également renforcée par la différence de pression qui existe entre le premier volume 25 et le deuxième volume 22 lors de l'opération d'une des sources 21 telles qu'un source de plasma ou un injecteur à gaz, placées dans le premier volume 25.

Le premier volume 25 de la chambre d'évaporation est pompé par une première unité de pompage 13 constituée d'un puit de pompage 32 comprenant un panneau cryogénique 15 offrant ainsi une surface de condensation, une ou plusieurs pompes secondaires cryogéniques servant à la fois pour la descente en vide de la chambre et pour le pompage des éléments en présence lors de la croissance de couches, un sublimateur de Titane 14 pour assurer la descente en vide. Le deuxième volume 22 délimité par la plaque 23 est pour sa part pompé par une pompe turbo-moléculaire 24 et un panneau réservoir 28 à circulation d'Azote liquide pour le pompage des espèces en présence lors de la croissance de couches et lors de l'ouverture du cache 27 de la source sélectionnée correspondante.

La figure 3 montre une vue de dessus de la plaque 23 décrite dans le mode de réalisation précédent et correspondant à la figure 2. Cette plaque 23 comporte des évidements 26 qui ont une forme elliptique. Cette forme elliptique résulte de la prise en considération de la forme tubulaire des sources de matériau 17 et de l'inclinaison de leur axe principal 18 par rapport à la plaque 23. Le double trait 33 schématise le décrochement de la plaque 23 en son milieu, apparent sur la figure 2.

Les sources de matériau 17 ayant un axe principal 18 placées dans le deuxième volume 22 délimité par la paroi 23 et les sources 21 telles qu'une source de plasma ou injecteur à gaz placées dans le premier volume 25 sont utilisées dans cette chambre d'évaporation

pour obtenir la croissance de couches d'oxyde, de nitrure ou de semi-conducteurs.

REVENDICATIONS

1. Chambre d'évaporation de matériaux comprenant une chambre à vide (10), une première unité de pompage (13) pour pomper ladite chambre et des sources de matériau, caractérisée en

5 ce que :

..... une paroi (23) pouvant assurer une étanchéité totale ou partielle au vide, délimite au sein de la chambre à vide (10) un premier volume (25) pompé par ladite première unité de pompage (13) et un deuxième volume (22) pompé par une deuxième unité de pompage (24),

..... - certaines desdites sources de matériau (17) ayant un axe principal (18) sont placées dans le deuxième volume (22) et d'autres sources (21) sont placées dans le premier volume (25),

15 - ladite paroi (23) comporte des évidements (26), chaque évidement (26) étant centré sur l'axe principal (18) d'une des sources de matériau (17) ayant un axe principal (18),

et en ce que,

20 - la chambre comprend des moyens (27) pour obturer ou dégager chacun desdits évidements (26), lesdits moyens (27) étant contrôlés individuellement pour protéger les sources de matériau (17) ayant un axe principal d'évaporation (18) non utilisées.

25 2. Chambre d'évaporation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens (27) pour obturer ou dégager lesdits évidements (26) comprennent des caches.

30 3. Chambre d'évaporation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que lors d'une croissance, le débit, à travers les évidements (26) dégagés, des éléments constitutifs des matériaux venant du premier volume (25) est pompé par la deuxième unité de pompage (24).

4. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la paroi (23) pouvant assurer une étanchéité totale ou partielle au vide comprend une plaque.

5. Chambre d'évaporation selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la première unité de pompage (13) comprend une pompe primaire et une pompe secondaire.
5. Chambre d'évaporation selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la deuxième unité de pompage (24) comprend une pompe secondaire.
10. Chambre d'évaporation selon les revendications 5 et 6, caractérisée en ce que le premier volume (25) et le deuxième volume (22) comprennent au moins un panneau réservoir (16, 28) à azote liquide.
15. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le deuxième volume (22) délimité par la paroi (23) est à une pression inférieure à 10^{-7} Torr.
20. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la chambre d'évaporation comprend des moyens de contrôle (16) de la pression pour mesurer indépendamment la pression dans le premier volume (25) et le deuxième volume (22).
25. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que les sources de matériau (17) ayant un axe principal (18) placées dans le deuxième volume (22) comprennent des cellules à creusets chauffés par effet Joule.
30. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que les sources de matériau (17) ayant un axe principal (18) placées dans le deuxième volume (22) comprennent des canons à évaporation (20) par bombardement électronique.
35. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que les sources (21) placées dans le premier volume (25) comprennent au moins une source de plasma.
13. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisée en ce que les sources (21)

5. Chambre d'évaporation selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la première unité de pompage (13) comprend une pompe primaire et une pompe secondaire.

5. Chambre d'évaporation selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la deuxième unité de pompage (24) comprend une pompe secondaire.

10 7. Chambre d'évaporation selon les revendications 5 et 6, caractérisée en ce que le premier volume (25) et le deuxième volume (22) comprennent au moins un panneau réservoir (16, 28) à azote liquide.

8. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le deuxième volume (22) délimité par la paroi (23) est à une pression inférieure à 10^{-7} mbar.

15 9. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la chambre d'évaporation comprend des moyens de contrôle (16) de la pression pour mesurer indépendamment la pression dans le premier volume (25) et le deuxième volume (22).

20 10. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que les sources de matériau (17) ayant un axe principal (18) placées dans le deuxième volume (22) comprennent des cellules à creusets chauffés par effet Joule.

25 11. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que les sources de matériau (17) ayant un axe principal (18) placées dans le deuxième volume (22) comprennent des canons à évaporation (20) par bombardement électronique.

30 12. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que les sources (21) placées dans le premier volume (25) comprennent au moins une source de plasma.

35 13. Chambre d'évaporation selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisée en ce que les sources (21)

placées dans le premier volume (25) comprennent au moins un injecteur à gaz.

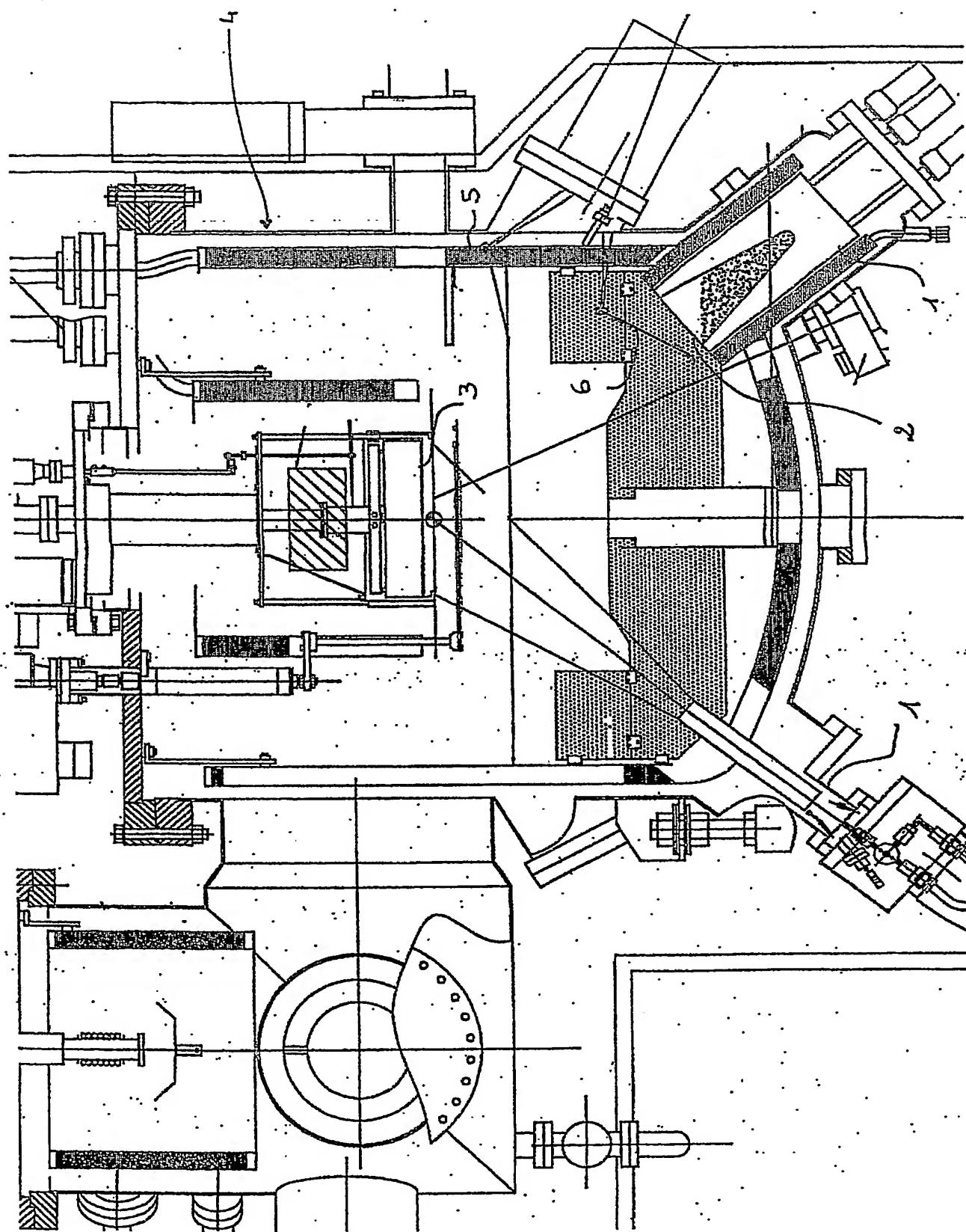


FIGURE 1

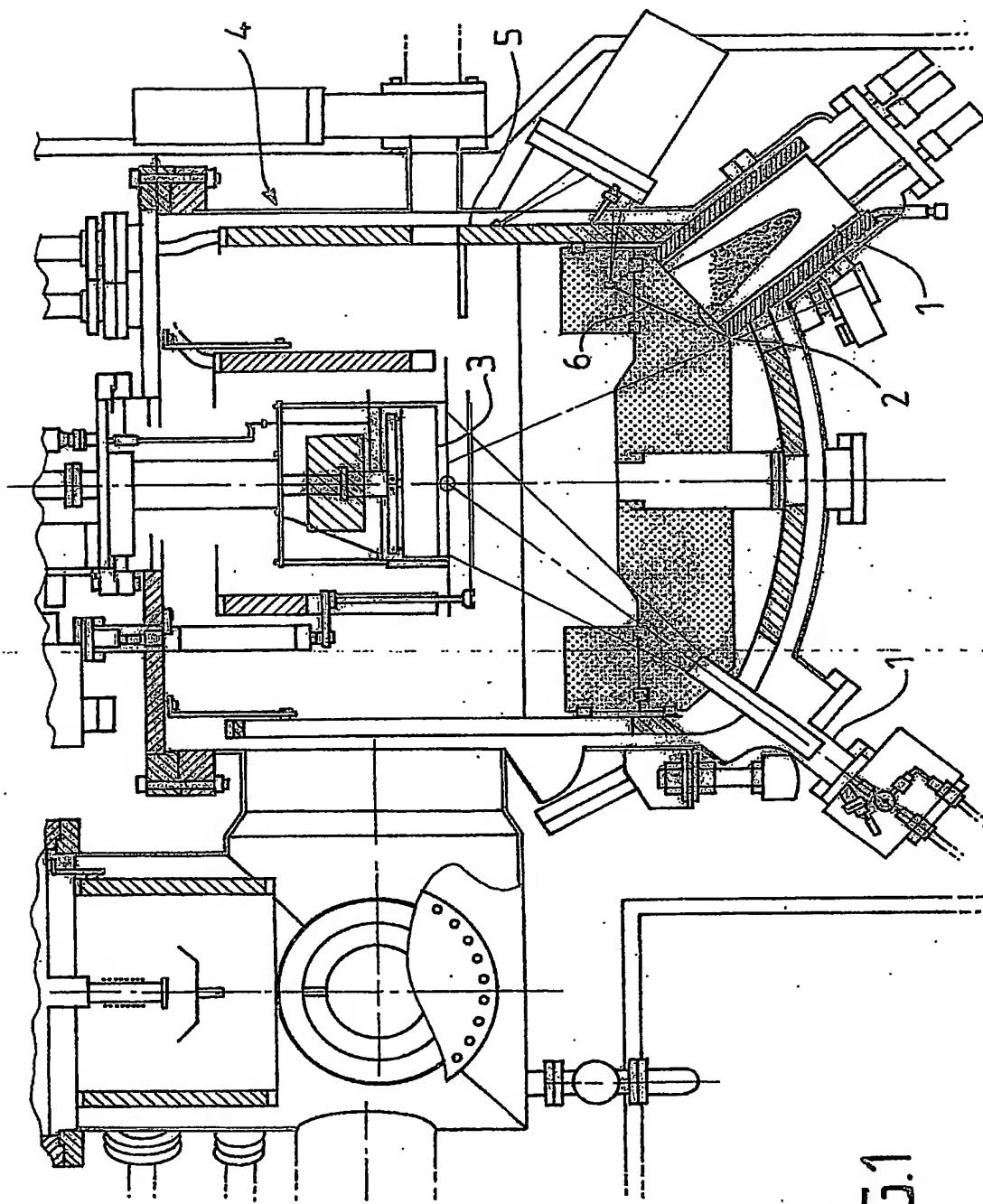


FIG.1

2/3

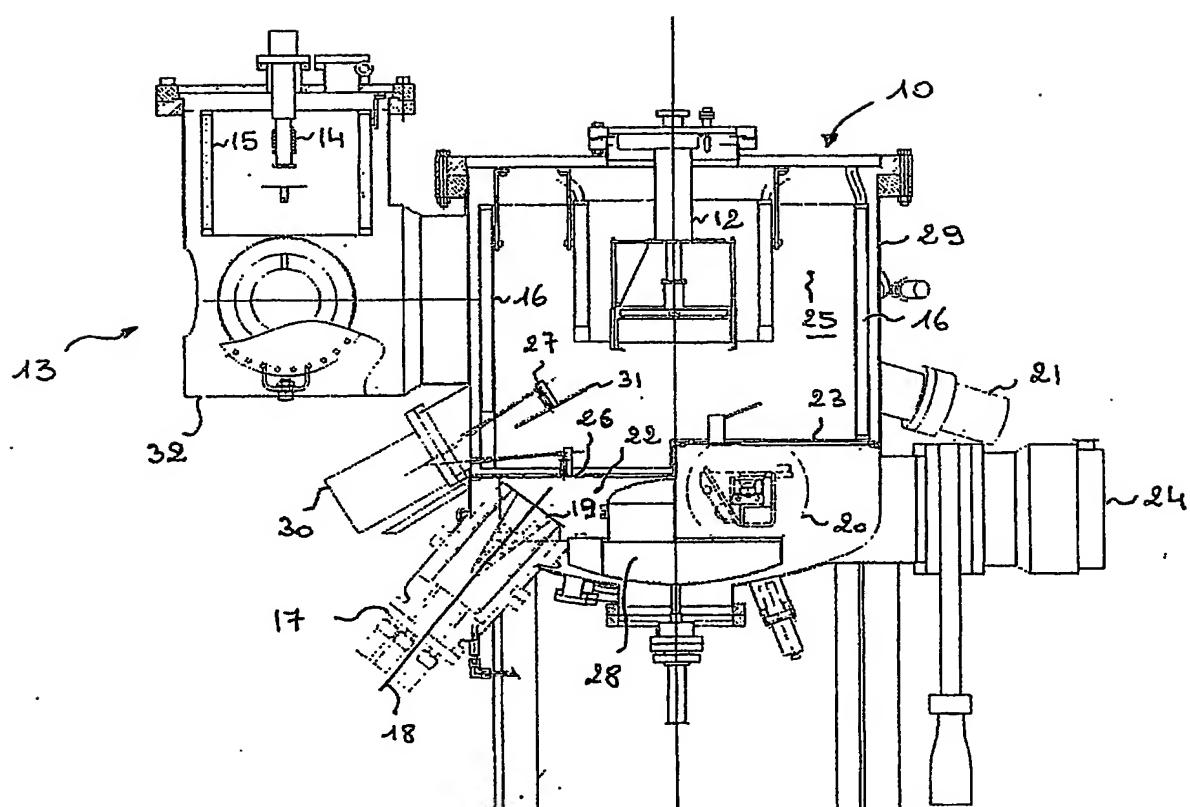


FIGURE 2

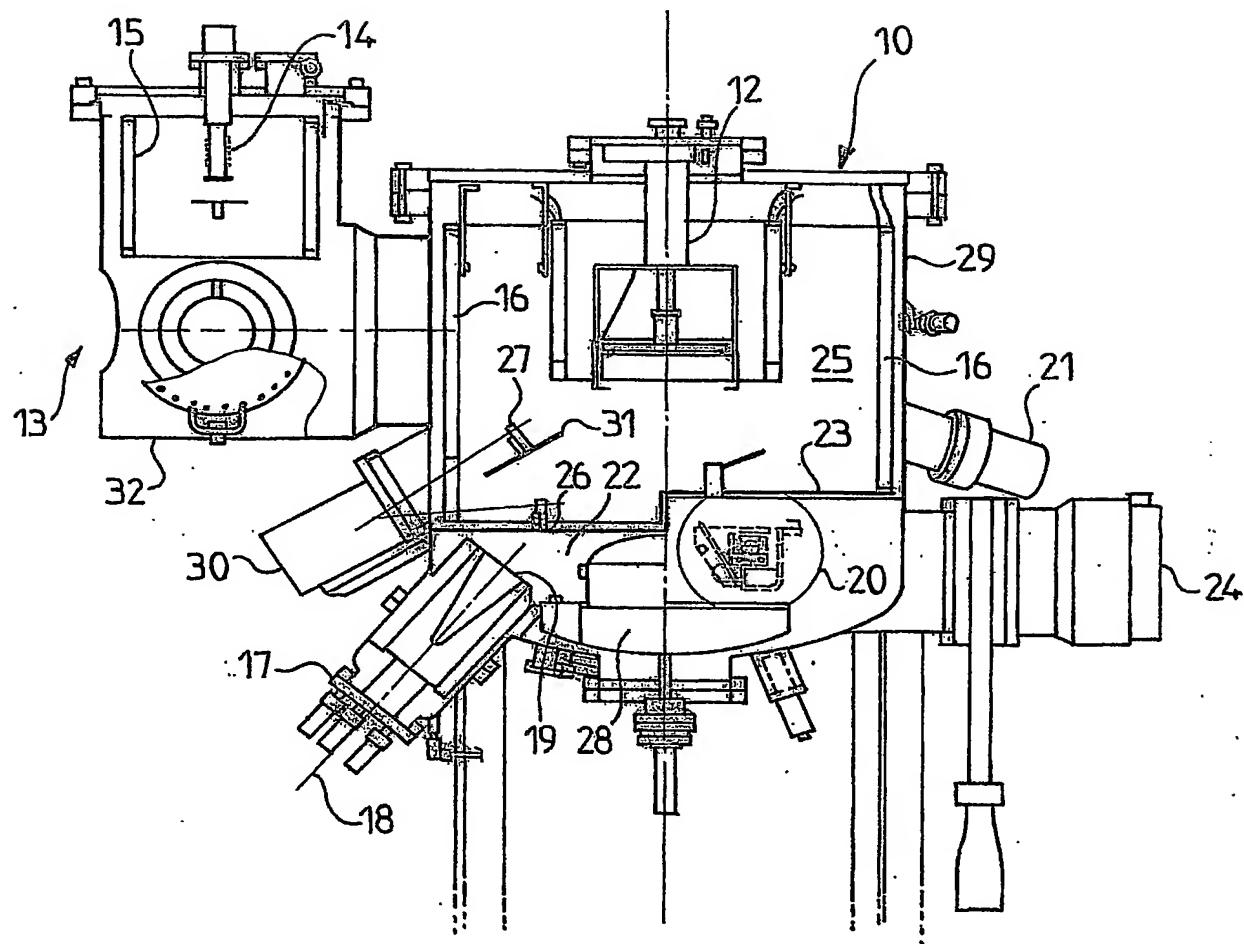


FIG. 2

3/3

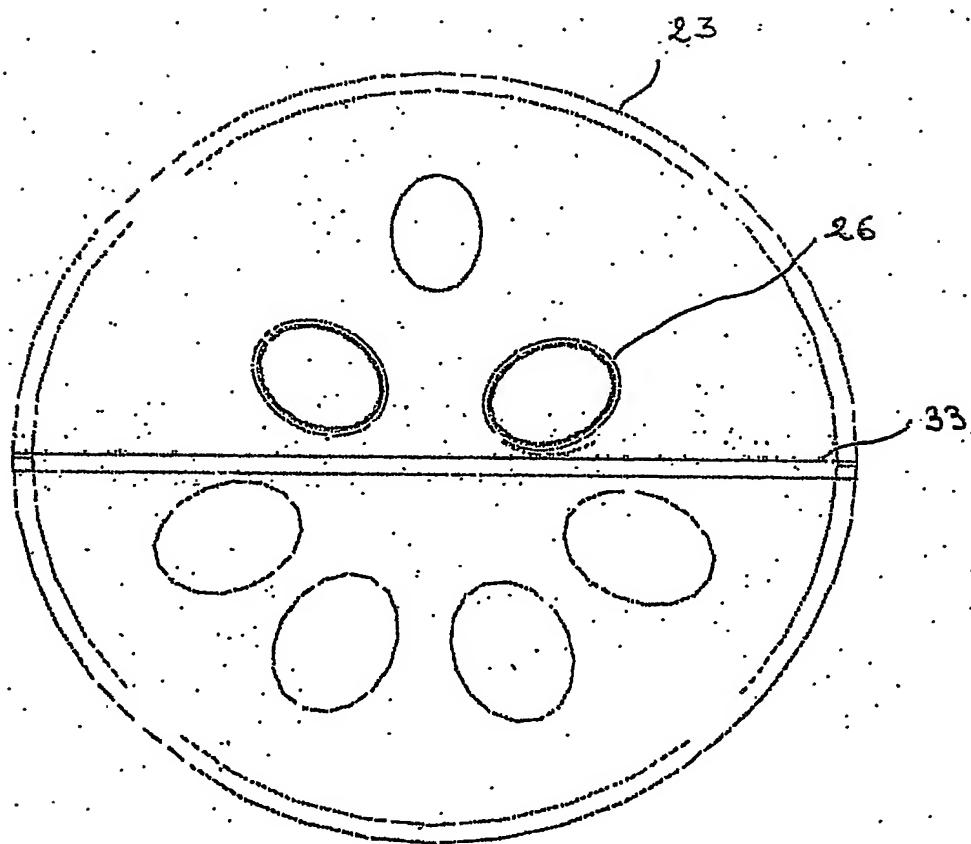


FIGURE 3

3/3

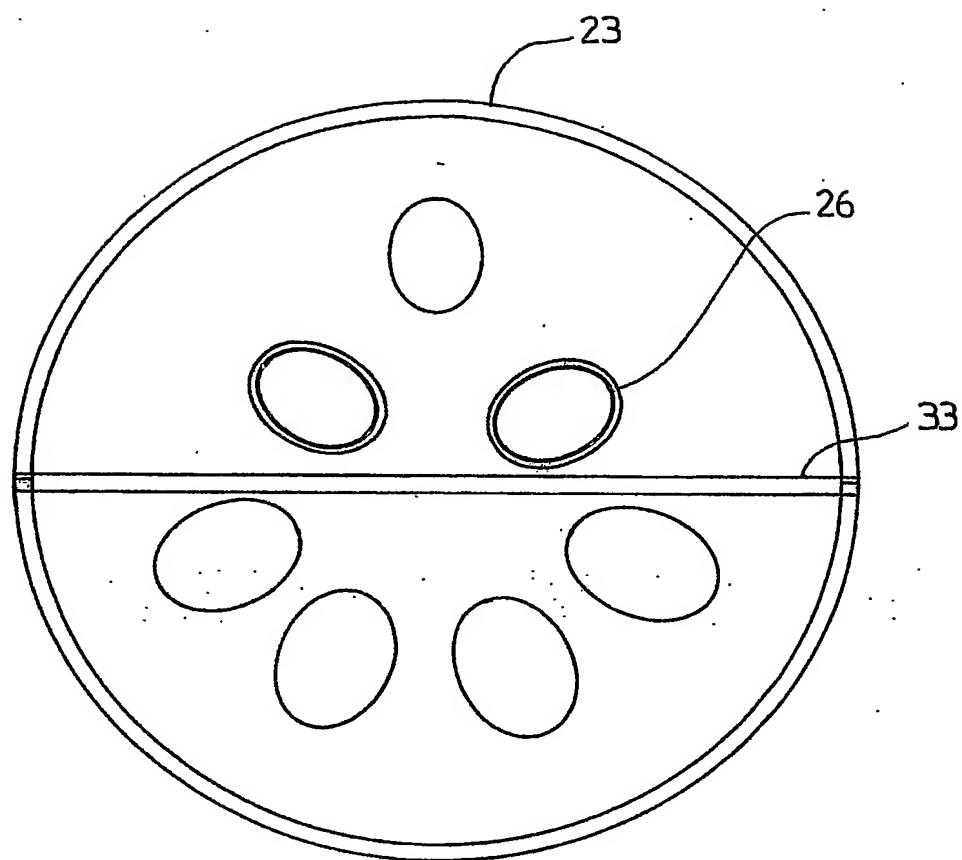


FIG. 3

BREVET D'INVENTION

Désignation de l'inventeur

Vos références pour ce dossier	N930FR	
N°D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0207501	
TITRE DE L'INVENTION		
CHAMBRE D'EVAPORATION DE MATERIAUX SOUS VIDE A POMPAGE DIFFERENTIEL		
LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):	Alain MICHELET	
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):		
Inventeur 1		
Nom	CHAIX	
Prénoms	Catherine	
Rue	92, Elysée 2	
Code postal et ville	78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD	
Société d'appartenance		
Inventeur 2		
Nom	JARRY	
Prénoms	Alain	
Rue	1, rue Léon Robert	
Code postal et ville	78480 VERNEUIL SUR SEINE	
Société d'appartenance		
Inventeur 3		
Nom	NUTTE	
Prénoms	Pierre-André	
Rue	30, rue des Dames	
Code postal et ville	75017 PARIS	
Société d'appartenance		
Inventeur 4		
Nom	LOCQUET	
Prénoms	Jean-Pierre	
Rue	Toedistrasse 5	
Code postal et ville	8810 HORG	
Société d'appartenance		
Inventeur 5		
Nom	FOMPEYRINE	
Prénoms	Jean	
Rue	Im unteren Baumgarten 29	
Code postal et ville	8820 WAEDENSWIL	
Société d'appartenance		

Inventeur 6

Nom	SIEGWART
Prénoms	Heinz
Rue	in de Ey 39
Code postal et ville	8047 ZÜRICH
Société d'appartenance	

DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE	PARIS, LE 17 FEVRIER 2003
--	----------------------------------

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



CATHERINE Alain
C.P.I. bm (92-1045 i)
Cabinet HARLE ET PHELIP

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.